

SIO2-SI硅衬底

产品名称	SIO2-SI硅衬底
公司名称	南京牧科纳米科技有限公司
价格	170.00/块
规格参数	品牌:MKNANO 型号:10093X 尺寸:4英寸
公司地址	江苏省南京市江宁区科学园芝兰路18号
联系电话	025-66171690 18052095282

产品详情

以下是SiO₂/Si衬底的照片：

氧化层厚度和SiO₂/Si颜色对照表

以下图片为公司IC百级超净室内实拍，所有硅片加工、分装均在IC超净室内进行，保证产品质量，因为

专业所以质优！

常见的各种氧化工艺

热氧化法-将硅片置于高温下，通以氧化的气氛，使硅表面一薄层的硅转变为二氧化硅的方法。

常见的热氧化工艺类别及特点：

1、干氧氧化：

干氧氧化法-氧化气氛为干燥、纯净的氧气。氧化膜致密、针孔密度小、适合光刻、质量最好，但氧化速度最慢，成本最高。

2、水汽氧化：

水汽氧化法-氧化气氛为纯净的水汽。氧化速度最快，但氧化膜疏松，针孔密度大，质量最差，光刻容易浮胶。

3、湿氧氧化：

湿氧氧化法-氧化气氛为纯净的氧气+纯净的氢气。氧化膜质量和氧化速度均介于干氧氧化和水汽氧化之间，质量也介于二者之间。

三种热氧化方式，干氧氧化的氧化层质量最好，成本最高；我司的硅片氧化层500nm以下采用纯干氧氧化，氧化层品质绝佳，绝缘性非常好，且采用我司独创新型专利氧化工艺技术，氧化层中缺陷与电荷最少，同时硅片的价格优惠，期待与广大新老客户合作双赢；（如500nm以下客户要求采用湿氧氧化也可以）

SIO₂-SI衬底CVD-MOS₂，WS₂生长实例：

CVD-WS₂

CVD-MOS₂单层连续薄膜

CVD-三角形MOS₂

产品信息：

产品名称（单抛光）	商品编码	货号	尺寸	P或N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1301	100931	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1302	100932	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1303	100933	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1304	100934	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1305	100935	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1306	100936	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1307	100937	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1308	100938	4英寸	P型/N
氧化硅片SiO2硅片 单抛光	MK1309	100939	4英寸	P型/N